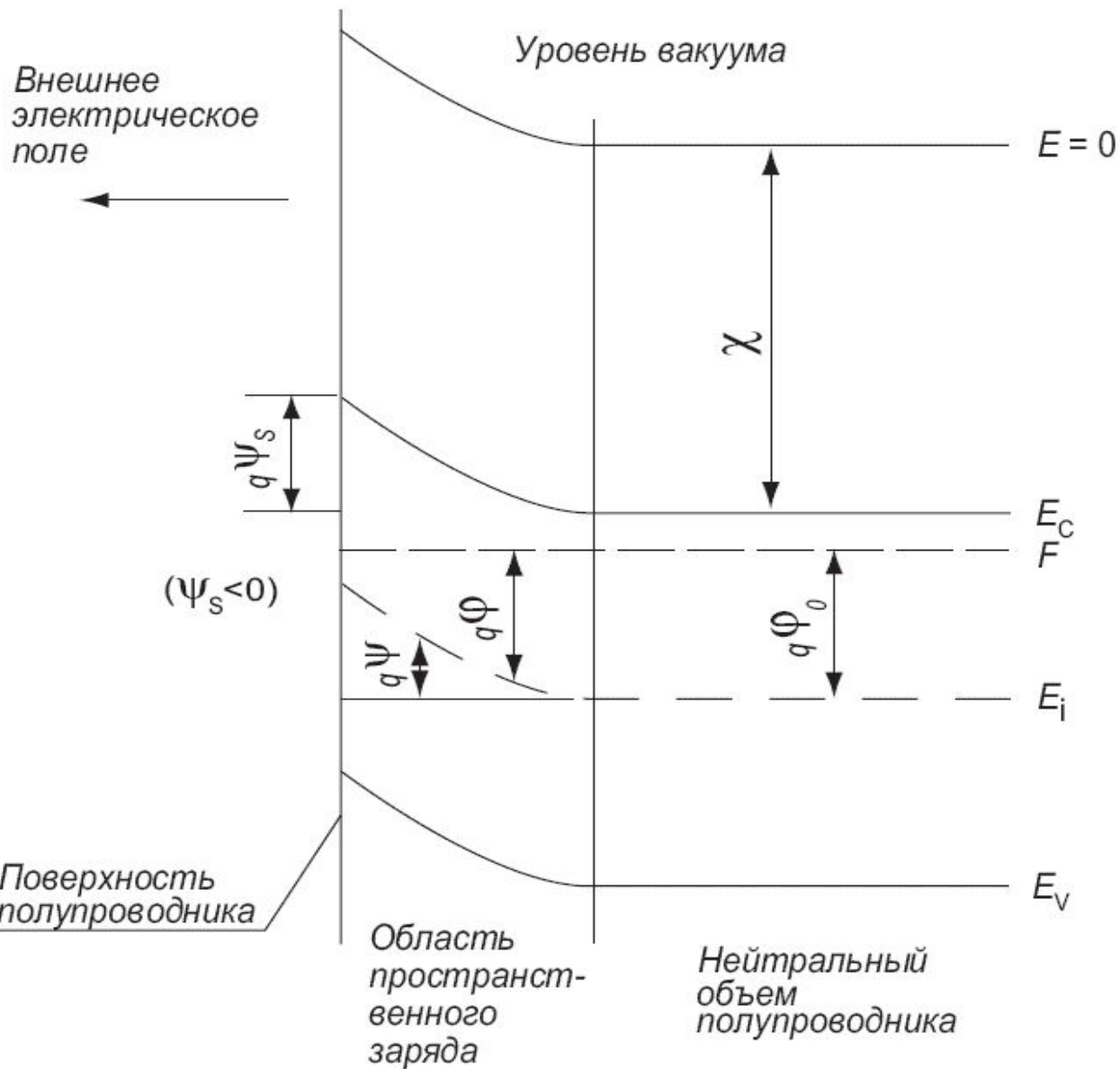
The page features several decorative, hand-drawn black lines. A vertical line on the left side is partially enclosed by a large, thin, curved shape that loops around it. Another curved line is positioned in the upper right corner. A long, thin, curved line spans across the bottom of the page, starting from the left and ending on the right.

Зонная диаграмма ОПЗ полупроводника

ОПЗ

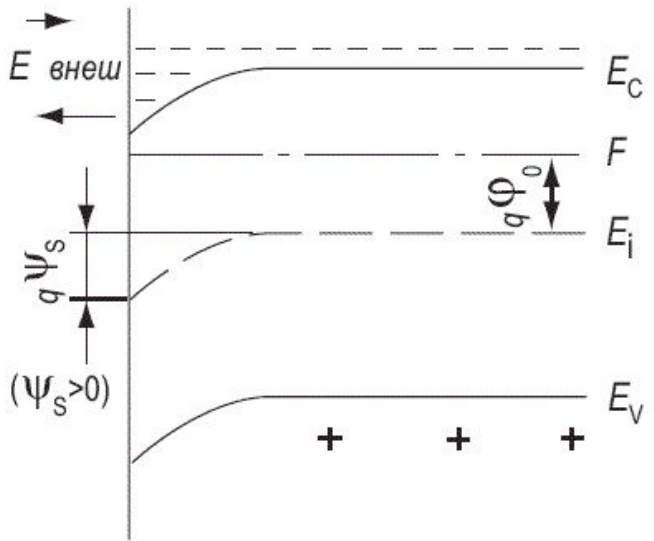
- - приповерхностная область полупроводника, в которой под действием внешнего поля возникает заряд.



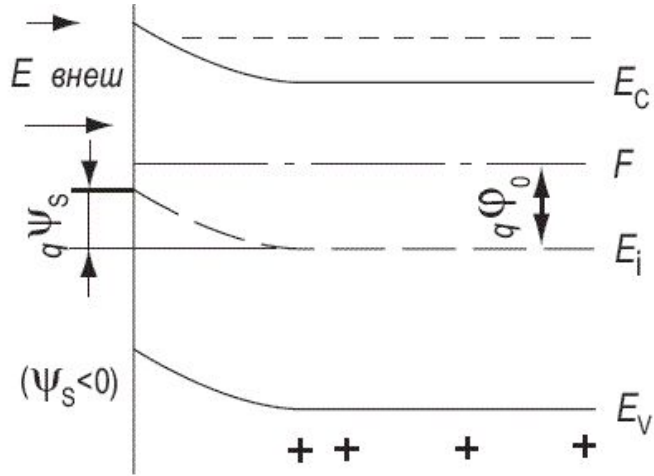
Состояния поверхности полупроводника

- Обогащение
- Обеднение
- Слабая инверсия
- Сильная инверсия

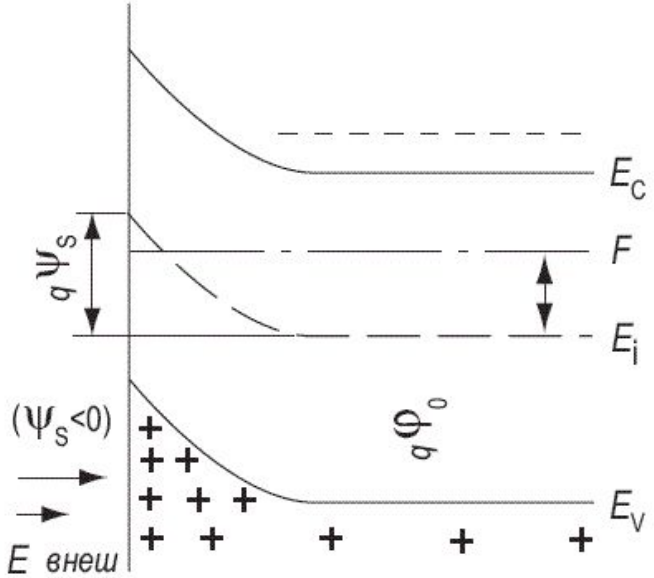
П-ТИП



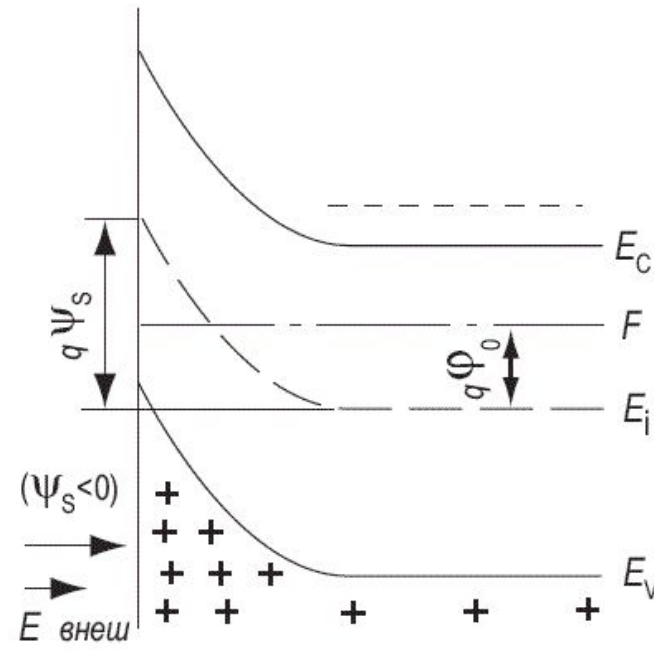
Обогащение



Обеднение



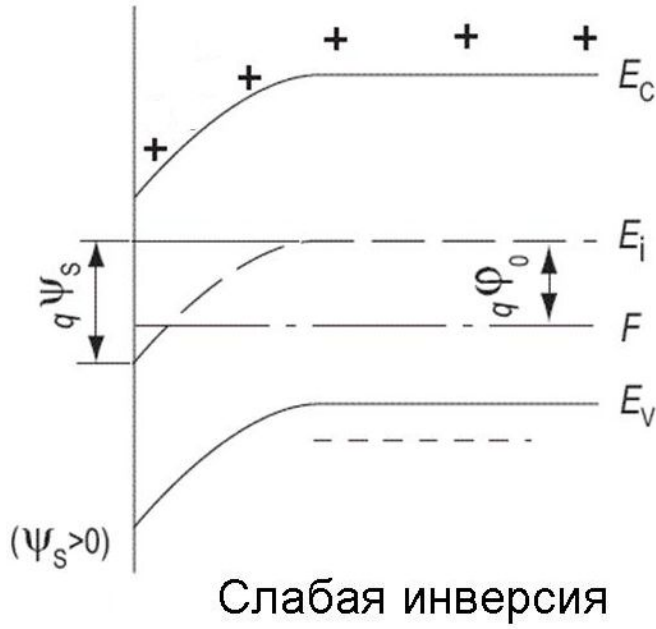
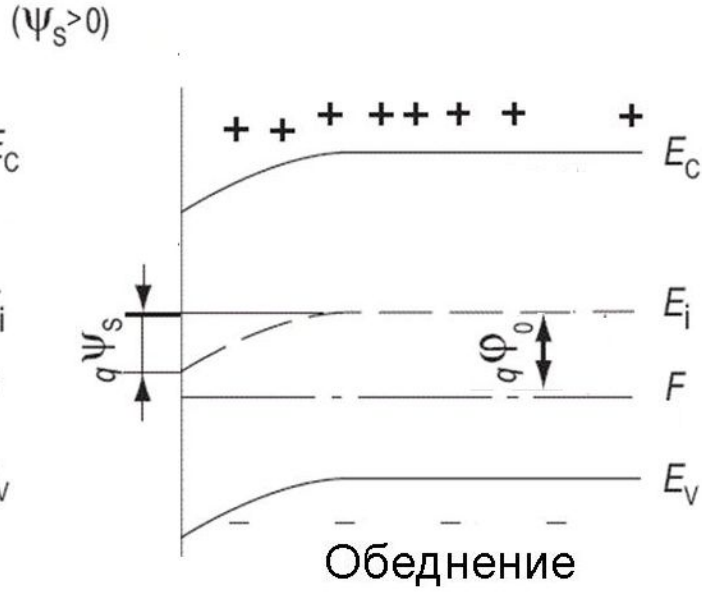
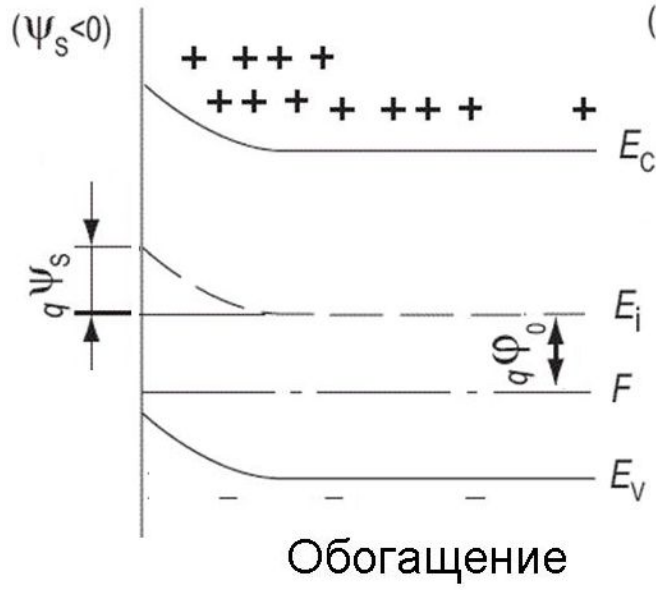
Слабая инверсия



Сильная инверсия

П-ТИП

Р-ТИП



Р-ТИП

Обогащение

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация основных носителей больше, чем концентрация основных носителей в нейтральном объеме

Обеднение

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей меньше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме, но больше, чем поверхностная концентрация неосновных носителей

Слабая инверсия

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей больше, чем поверхностная концентрация основных, но меньше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме

Сильная инверсия

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей больше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме